【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成26年9月11日(2014.9.11)

【公開番号】特開2014-41372(P2014-41372A)
【公開日】平成26年3月6日(2014.3.6)
【年通号数】公開・登録公報2014-012
【出願番号】特願2013-207038(P2013-207038)
【国際特許分類】
Ｇ０２Ｆ　1/1343　(2006.01)
Ｇ０２Ｆ　1/1368　(2006.01)
Ｇ０９Ｆ　9/00　(2006.01)
Ｇ０９Ｆ　9/30　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/336　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　29/786　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０２Ｆ　1/1343
Ｇ０２Ｆ　1/1368
Ｇ０９Ｆ　9/00　３３８
Ｇ０９Ｆ　9/30　３３８
Ｇ０９Ｆ　9/30　３３７
Ｈ０１Ｌ　29/78　６１２Ｚ
Ｈ０１Ｌ　29/78　６１２Ｄ
Ｈ０１Ｌ　29/78　６１６Ｔ

【手続補正書】
【提出日】平成26年7月25日(2014.7.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
トランジスタと、
画素電極と、
ゲート配線と、
島状のパターンと、を有し、
前記トランジスタは、前記画素電極に電気的に接続されており、
前記トランジスタは、前記ゲート配線に電気的に接続されており、
前記画素電極は、表面に凹凸を有し、
前記画素電極の下方の領域に前記島状のパターンが設けられており、
前記ゲート配線と、前記島状のパターンは、同一の導電膜をエッチング加工することによって形成されたものであることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
トランジスタと、
画素電極と、
ゲート配線と、
島状のパターンと、を有し、
前記トランジスタは、前記画素電極に電気的に接続されており、

前記トランジスタは、前記ゲート配線に電気的に接続されており、
前記画素電極の下方の領域に前記島状のパターンが設けられており、
前記ゲート配線と、前記島状のパターンは、同一の導電膜をエッチング加工することによって形成されたものであることを特徴とする半導体装置。